

Фосфид индия (InP)

Фосфид индия (InP)

Производитель:

АО «Диполь Технологии»

Цена:

Цена по запросу

Описание

Фосфид индия (InP) является важным соединением III-V и полупроводниковым материалом с такими преимуществами, как высокая подвижность электронов, хорошая радиационная стабильность и большой зазор. Он имеет гранецентрированную кубическую ("цинкбленд") кристаллическую структуру, идентичную структуре GaAs и большинства III-V полупроводников.

Применение

Пластины из монокристаллов фосфида индия применяются в телекоммуникациях и СВЧ технике для компонентов волоконно-оптических систем связи (ВОЛС), включая DWDM лазеры, вертикально-излучающие лазеры (VCSEL), лазеры с диодной накачкой, лавинных (APD) и PIN фотодиодов, усилителей и т.д.

Спецификация

Фосфид индия (InP)

Подложки InP с другими параметрами также доступны по запросу.

Производство: Китай. Также доступны эпитаксиальные структуры на основе подложек InP и других полупроводников группы АЗВ5.